2SC697, 2SC697A

シリコン NPN エピタキシアルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

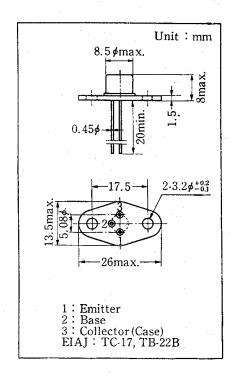
中電力増幅用/Medium Power Amplifier 2SA547, 2SA547A とコンプリメンタリ/Complementary pair with 2SA547, 2SA547A

特 徵/Features

- コレクタ・ベース電圧 VcBO が大きい。/High VcBO
- コレクタ電流 Ic が大きい。/High Ic

最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item		Symbol	Value	Unit	
コレクタ・	2SC697	V_{CBO}	100	v	
ベース電圧	2SC697A	A CBO	130	V	
コレクタ・ エミッタ電圧	2SC697	V_{CEO}	60	77	
	2SC697A		80	V	
エミッタ・ベー	ス電圧	V_{EBO}	5	V	
コレクタ電流		$I_{\rm C}$	3	A	
ベース電流		IB	0.6	A	
コレクタ損失 (Tc=25°C)		Pc	10	W	
接合部温度		T_{j}	175	°C	
保存温度		Tstg	$-65 \sim +175$	°C	



電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
		I_{CBO}	$V_{CB}=30V$, $I_{E}=0$			3	μΑ
コレクタしゃ断 電流	2SC697	I _{CEO}	$V_{CE}=60V$, $I_{B}=0$			5	
	2SC697A		$V_{\text{CE}} = 80V$, $I_{\text{B}} = 0$			5	mA
エミッタしゃ断電	流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V$, $I_C=0$			100	μΑ
直流電流増幅率		h _{FE1} *	V _{CE} =3V, I _C =100mA**	30		173	
		h _{FE2}	$V_{CE} = 3V, I_{C} = 1A^{**}$	28			
トランジション居	波数	$f_{\mathbf{T}}$	$V_{CB}=10V$, $-I_{E}=50$ mA	35			MHz
ベース・エミッタ電圧		$V_{ m BE}$	$V_{CE} = 3V$, $I_{C} = 100 \text{mA**}$			0.8	V.
コレクタ・エミッタ飽和電圧 Vc		V _{CE(sat)}	$I_{\rm C} = 2A$, $I_{\rm B} = 0.4A^{**}$			0.8	v

** パルス測定/Pulse Test

* h_{FE1} ランク分類/h_{FE1} Classifications

h _{FE1}	30~50	38~77	57~115	85~173
分類	ΔJ	ΔI, F	ΔH, E, ΔB	۵D, ۵A

△ 保守ランク/Maintenance

This datasheet has been downloaded from:

www. Data sheet Catalog.com

Datasheets for electronic components.